



بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۳، دانشگاه شهید بهشتی



مطالعه تزویج نوری تنظیم پذیر حرارتی مابین موجبر نیمه‌رسانای بلور فوتونی و بلور فوتونی مدرج دو بعدی

سمیه اسکویی^۱؛ جمال بروستانی^۱

^۱ گروه فیزیک حالت جامد و الکترونیک، دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز، تبریز

در این کار، تزویج نوری موجبر بلور فوتونی نیمه‌رسانا با بلور فوتونی مدرج دارای تغییرات تدریجی ثابت شبکه را بررسی می‌کنیم. با استفاده از روش محاسباتی تفاضلات متناهی در حوزه‌ی زمان بازده تزویج را در دماهای مختلف یک نیمه‌رسانای ذاتی بدست می‌آوریم. موجبر بلور فوتونی از جایگزین کردن تک میله‌ی آلومینا به ایندیم آنتیموان ساخته شده است. محاسبات تنظیم پذیری حرارتی مناسبی را در بازده تزویج نشان می‌دهد و با افزایش دما، بازده بهبود می‌یابد.

کلید واژه- بلور فوتونی، بلور فوتونی مدرج، تزویج گر، روش تفاضلات محدود در بازه‌ی زمانی، موجبر بلور فوتونی.

The study of thermal tunable coupling between a semiconducting photonic crystal waveguide and graded index photonic crystal

Somayeh Oskooi¹; Jamal Barvestani¹

¹ Department of solid state physics & electronic, Faculty of Physics, University of Tabriz, Tabriz

In this work, we study the light coupling between semiconducting photonic crystal waveguide and graded index photonic crystal. Using the finite difference time domain method, we evaluate the coupling efficiency at various temperatures for an intrinsic semiconductor. Photonic crystal waveguide is constructed by replacing one row of alumina rods by InSb rods. Calculation shows a proper thermal tunability of coupling efficiency and the efficiency is improved by increasing the temperature.

Keywords: Photonic crystal, graded index photonic crystal, Coupler, Finite Difference Time Domain, Photonic crystal Waveguide

۱- مقدمه

پله‌ای برای پارامترهای محیط در نظر گرفته می‌شود. همچنین میدان‌های الکترومغناطیسی گسسته سازی شده و معادلات ماکسول با تقریب تفاضلی آنها جایگزین و میدان‌های الکترومغناطیسی در طول زمان محاسبه می‌شوند. این روش به صورت شرطی پایدار است و عموماً مشکل همگرایی ندارد. این روش نیاز به منابع محاسباتی و حافظه‌ی بالایی مخصوصاً در سه بعد دارد.

مهم‌ترین نکته در این روش، شبیه‌سازی انتشار امواج در فضای سلول محاسباتی به فضای بینهایت برای نزدیک شدن حل عددی به واقعیت فیزیکی مسأله است. که در این مورد از شرط مرز جاذب با نام PML استفاده می‌شود. از سال ۱۹۹۴ فعالیت قابل توجهی در این زمینه به وجود آمده است که این امر مدیون کار اولیه‌ای است که برنگر در معرفی مواد جاذب بسیار موثر برای شرط مرزی جاذب نموده است. ابتکار برنگر در این است که امواج تخت با هر زاویه تابش و نوع قطبش و فرکانس با این ماده در مرز کاملاً مطابق می‌باشند. وی با اضافه کردن درجات آزادی بیشتری که از تجزیه‌ی میدانها به دو مؤلفه به‌دست می‌آید، توانست اینکار را انجام دهد. بنابراین در یک PML ایده‌آل نباید هیچ موج بازتابیده‌ای باقی بماند.

۳- شکل ساختار

موجبر بلور فوتونی مورد بررسی در این بخش متشکل از شبکه‌ی مربعی از میله‌های آلومینا با ثابت دی‌الکتریک ($\epsilon=9/61$) و شعاع $0/22a$ در زمینه‌ی هوا با ثابت دی‌الکتریک ($\epsilon=1$) می‌باشد. که ثابت شبکه‌ی آن $a=30\mu\text{m}$ بوده و شامل ۱۱ لایه در جهت x و ۲۹ لایه در جهت y می‌باشد. برای ایجاد موجبر یک ردیف از جنس میله‌ها را به ایندیم آنتیموان تغییر داده‌ایم. ثابت دی‌الکتریک نیمه-رساناها با تغییرات دمایی، تغییر می‌کند. در این بخش از طریق تغییرات دمایی بازده تزویج بین این موجبر بلور فوتونی و نوری با پهنای $10a$ را بوسیله تزویج‌گر بلور فوتونی مدرج دارای تغییرات تدریجی ثابت شبکه را مورد بررسی قرار می‌دهیم. تزویج‌گر دارای شبکه‌ی مربعی از میله‌های آلومینا با ثابت دی‌الکتریک ($\epsilon=9/61$) و شعاع $0/22a$ در زمینه‌ی هوا ($\epsilon=1$) می‌باشد. که ثابت شبکه‌ی آن در جهت y دارای تغییرات تدریجی بوده و در جهت x ثابت و برابر a می‌باشد. این بلور به صورت نمادین در

در سالهای اخیر بلورهای فوتونی به خاطر خواص جالبشان در کنترل انتشار نور در مقیاس طول موج، بسیار مورد توجه بوده است [۱]. موجبرهای بلور فوتونی (PCW)^۱، که از ایجاد یک نقص خطی در بلور فوتونی بدست می‌آید، از اهمیت زیادی در مدارات مجتمع فوتونی برخوردار است. یکی از مشکلات اصلی در این راستا، عدم تزویج مناسب بین مد خروجی سایر مدارات و موجبر بلور فوتونی می‌باشد که مربوط به تفاوت مقیاس آنهاست. بنابراین دستیابی به تلفات پایین تزویج چالش بزرگی در بحث بلور فوتونی می‌باشد. می‌توان با استفاده از تزویج‌گرهای بلور فوتونی مدرج بازده تزویج را تا حدی بهبود بخشید. چندین ساختارهای بلور فوتونی مدرج (GRIN PC)^۲ جهت تحقق تزویج در سالهای پیش ارائه شده از جمله: بلور فوتونی مدرج دارای تغییرات تدریجی ضریب شکست [۲]، بلور فوتونی مدرج دارای تغییرات تدریجی شعاع [۳]. اما ساخت بلور فوتونی مدرج با تغییر شعاع میله‌ها به دقت زیاد و با تغییر ضریب شکست به مواد بیشتری نیاز خواهد داشت. در این مطالعه شعاع و ضریب شکست ثابت می‌باشد و ثابت شبکه به طور تدریجی تغییر می‌کند. با استفاده از این تزویج‌گر، تزویج میان امواج نور و موجبر بلور فوتونی نیمه‌رسانا را در تغییرات دمایی مطالعه خواهیم کرد.

۲- روش محاسبات شبیه‌سازی

تفاضل متناهی در حوزه زمان که به صورت خلاصه از آن با نام FDTD یاد می‌کنند، روش مورد استفاده در این کار می‌باشد. الگوریتم تفاضل متناهی در حوزه زمان اولین بار توسط یی^۳ در سال ۱۹۶۶ ایجاد شد. در روش FDTD^۴ که روش پیاده‌سازی شده در این پروژه می‌باشد، ساختار مورد نظر به شبکه‌ای مربعی تقسیم بندی شده و تقریب

¹ Photonic Crystal Waveguide

² Graded Index Photonic Crystal

³ Yee

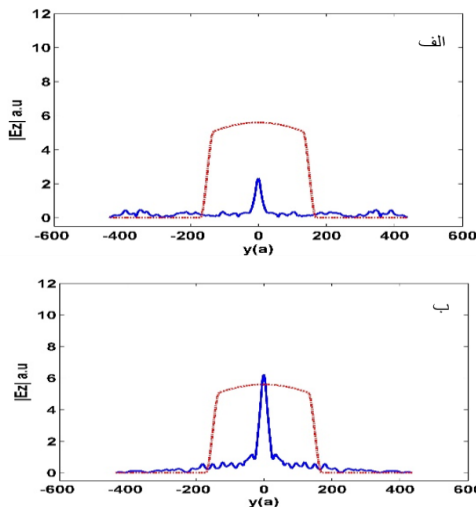
⁴ Finite Difference Time Domain

$$N(T) = 5.76 * 10^{20} T^{3/2} \exp\left(-\frac{0.26}{2k_B T}\right) \quad (4)$$

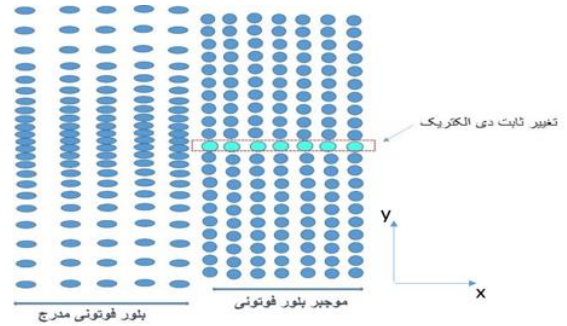
e بار الکتریکی الکترون ها، $m^* = 0.15m$ جرم مؤثر حاملین آزاد، e_0 گذردهی خلاء، K_B ثابت بولتزمن، T دما در کلوین می باشد. برای ایندیم آنتیموان $\epsilon_s = 17/71$ است.

۵- نتایج شبیه سازی

با استفاده از روش ابر سلول بر مبنای بسط موج تخت، مدهای موجبری در بلور فوتونی دو بعدی با تقارن شبکه مربعی و هندسه میله های دایروی را محاسبه کرده ایم. فرکانس نرمالیزه $\left(\frac{\omega a}{2\pi c}\right) \cdot 38$ ($\omega = 22/38 \text{ THz}$) مد نقص موجبر بلور فوتونی می باشد. همچنین این مد با استناد به مرجع [۴] پس از این که از داخل ساختار بلور فوتونی مدرج عبور می کند، به تدریج حالت جمع شدگی پیدا می کند و کانونی می شود و از طریق موجبر هدایت می شود. یک منبع نور با پالس گاوسی با پهنای $10a$ در سمت چپ تزویج گر قرار دادیم. حال با تغییر دما، می توان فرکانس پلاسمایی و در نتیجه ثابت دی الکتریک نقص خطی را تغییر داد. شایان ذکر است که این تغییرات دمایی در فرکانس تراهرتز ثابت دی الکتریک آلومینا را تغییر نمی دهد. بنابراین به جز نقص خطی بقیه ی ساختار ضریب دی الکتریک ثابتی خواهند داشت. شکل ۱ نمایشی از اندازه ی شدت میدان الکتریکی نور ورودی به ساختار و نور خروجی از موجبر در دماهای مختلف می باشد.



شکل ۱ نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می شود، ثابت شبکه در مرکز ساختار دارای کمترین مقدار ($0.375a$) و در لبه ها دارای بیشترین مقدار ($1/4a$) است. گام افزایشی ثابت شبکه برابر با $0.15a$ در نظر گرفته شده است. این تزویج گر شامل ۷ لایه در جهت x و ۲۸ لایه در جهت y می باشد. همچنین در مرزهای سیستم ۱۲ لایه PML استفاده شده است.



شکل ۱- تصویری نمادین از ساختار تزویج نوری متشکل از PCW و GRIN PC

۴- تئوری

جهت مطالعه ی تنظیم پذیری دمایی بازده تزویج، از معادله ی هلمهولتز میدان الکتریکی شروع می کنیم. معادله ی موج میدان الکتریکی به صورت زیر می باشد:

$$\nabla \times [\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r})] = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \epsilon(\omega) \mathbf{E}(\mathbf{r}) \quad (1)$$

در رابطه فوق ω فرکانس، c سرعت نور و $\epsilon(\omega)$ تابع دی الکتریک محیط است. تابعیت $\epsilon(\omega)$ در رابطه ی زیر داده می شود [۵].

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_s \left(1 - \frac{\omega_p^2(T)}{\omega^2}\right) \quad (2)$$

در این رابطه ϵ_s ضریب استاتیک و $\omega_p(T)$ فرکانس پلاسمایی می باشد، فرکانس پلاسمایی با توجه به رابطه ی زیر به شدت وابسته به دما می باشد.

$$\omega_p(T) = \left(\frac{N(T)e^2}{\epsilon_s \epsilon_0 m^*}\right) \quad (3)$$

در اینجا چگالی حاملین ذاتی برای ایندیم آنتیموان به صورت زیر داده می شود [۶]:

جدول ۱ بازده تزویج در دماهای مختلف

T (K)	$\eta_1 = \frac{\int Ez ^2_{PCW+GRIN}}{\int Ez ^2_{GRIN}}$	$\eta_2 = \frac{\int Ez ^2_{PCW+GRIN(output)}}{\int Ez ^2_{PCW+GRIN(input)}}$
۳۳۰	-۰/۴۲۵(dB)	٪۰/۴
۳۳۱	-۰/۱۹(dB)	٪۱/۸
۳۳۲	-۰/۵۶(dB)	٪۵/۴۳
۳۳۳	-۰/۸۶(dB)	٪۸/۳۷
۳۳۴	۱/۱۶(dB)	٪۱۱/۱۷
۳۳۵	۱/۲(dB)	٪۱۱/۷۰
۳۳۶	۱/۳۹(dB)	٪۱۳/۳۸
۳۳۷	۱/۷۱(dB)	٪۱۶/۵۳
۳۳۸	۱/۸۲(dB)	٪۱۷/۵۴
۳۳۹	۲/۱۴(dB)	٪۲۰/۶۷
۳۴۰	۲/۳۷(dB)	٪۲۲/۸۱
۳۴۱	۲/۵۳(dB)	٪۲۴/۴۱
۳۴۲	۲/۷۶(dB)	٪۲۶/۶۰
۳۴۲/۸	۳/۱(dB)	٪۳۰/۸

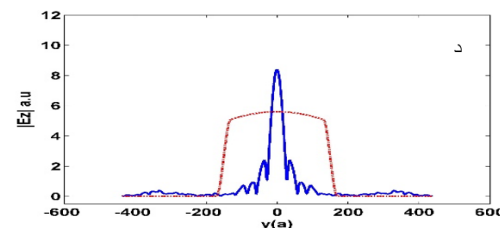
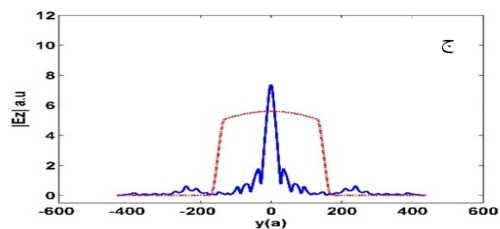
با توجه به نمودار بالا، بیشینه‌ی بازده تزویج برای دمای $342/8 \text{ K}$ اتفاق می افتد و در این دما شدت میدان الکتریکی نیز بیشترین مقدار خود را دارد.

۶- نتیجه گیری

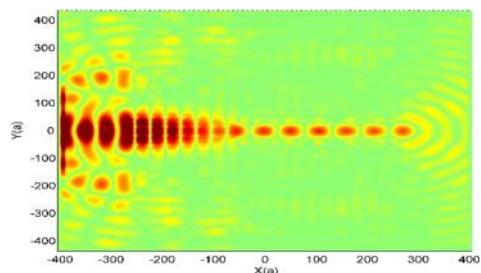
تغییرات دمایی تزویج نوری بین یک موجبر نیم رسانای بلور فوتونی و بلور فوتونی مدرج بررسی شد. نتایج نشان می دهد که بازده تزویج در چنین سیستم هایی می تواند بصورت حرارتی بعد از ساخت وسیله تنظیم گردد.

مراجع

- [1] S. John, *Strong localization of photons in certain disordered dielectric super-lattices*, **Phys. Rev. Lett.** 58 (1987)
- [2] H. Kurt and D. S. Citrin. *A Novel Optical Coupler Design With Graded-Index Photonic Crystals*. **IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS**, 19, 19, (2007)
- [3] H. T. Chien, C. C. Chen, *Waveguide coupler formed by a Graded Photonic Crystal*. **JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY** (2009)
- [4] A. O. Cakmak, E. Colak, H. Caglayan, H. Kurt, and E. Ozbay. *High efficiency of graded index photonic crystal as an input coupler*. **J. Appl. Phys.** 105, 10370 (2009)
- [5] P. Halevi, F. Ramos-Mendieta, **Phys. Rev. Lett.** 85 (9) 1875 (2000).
- [6] H. C. Hung, C. J. Wu, and S. J. Chang, **Journal of Appl. Phys.**, 110, 093110 (2011).

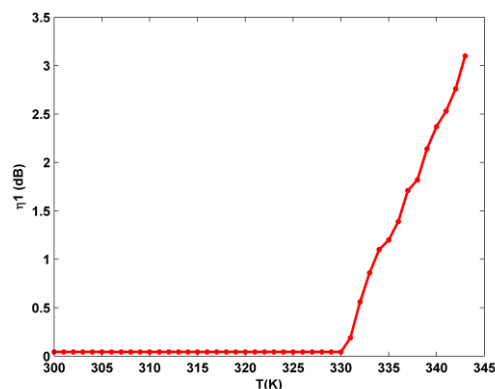


شکل ۱- شدت میدان الکتریکی نور ورودی (خط چین قرمز) و در خروجی موجبر (خط آبی) در دماهای الف) (۳۳۱ ب) (۳۳۵ ج) (۳۳۹ د) (۳۴۲/۸۰۵ کلون



شکل ۳- نمودار توزیع فضایی میدان مربوط به تزویج گر بلور فوتونی مدرج با تغییرات تدریجی ثابت شبکه در دمای ۳۴۲/۸۰۵ کلون

بازده تزویج در حالت های مختلف در جدول ۱ لیست شده است (η_1 : نسبت شدت نور خروجی به نور ورودی، η_2 : شدت نور خروجی در حضور موجبر نسبت به حالت عادی) [۴].



شکل ۴- تغییرات میزان بازده تزویج نور برای دماهای مختلف